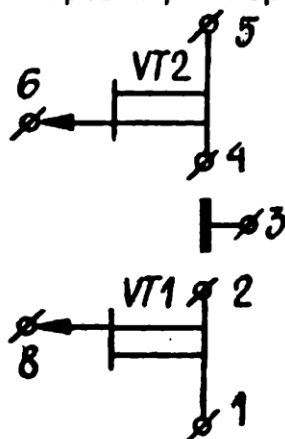


K504HT3A — K504HT3B, KP504HT3A — KP504HT3B, K504HT4A — K504HT4B, KP504HT4A — KP504HT4B

Микросхемы представляют собой сильноточную согласованную пару полевых транзисторов с *p-n* переходом и *p*-каналом,



Электрическая схема K504HT3, KP504HT3, K504HT4, KP504HT4

Назначение выводов: 1 — сток VT1; 2 — исток VT1; 3 — корпус; 4 — исток VT2; 5 — сток VT2; 6 — затвор VT2; 8 — затвор VT1.

Электрические параметры

Напряжение отсечки	≤ 5 В
Разность напряжений затвор — исток K504HT3, KP504HT3	≤ 30 мВ
Начальный ток стока:	
K504HT3A, KP504HT3A, K504HT4A, KP504HT4A	1,5...7,5 мА
K504HT3Б, KP504HT3Б, K504HT4Б, KP504HT4Б	5...15 мА
K504HT3В, KP504HT3В, K504HT4В, KP504HT4В	7,5...20 мА
Ток утечки затвора	≤ 2 нА
Крутизна характеристики:	
K504HT3A, KP504HT3A, K504HT4A, KP504HT4A	≥ 1,5 мА/В
K504HT3Б, KP504HT3Б, K504HT4Б, KP504HT4Б	≥ 3 мА/В
K504HT3В, KP504HT3В, K504HT4В, KP504HT4В	≥ 5 мА/В
Коэффициент шума при $R_f = 1$ МОм, $f = 1$ кГц	≤ 4 дБ
Отношение значений крутизны характеристики транзисторов в паре K504HT4, KP504HT4	≥ 0,85
Температурный дрейф напряжения смещения:	
K504HT3, KP504HT3	≤ 50 мкВ/°С
K504HT4, KP504HT4	≤ 300 мкВ/°С

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение затвор — сток	10 В
Прямое напряжение затвор — исток	$\geq -0,2$ В
Температура окружающей среды	$-45...85$ °С